

Содержание

● Электронные свойства полупроводников

Давидович М.В.

Аналитическое решение одномерного уравнения Шредингера с линейным потенциалом в диоде 651

● Поверхность, границы раздела, тонкие пленки

Фефелов С.А., Казакова Л.П., Богословский Н.А., Былев А.Б.

Механизмы токопрохождения в структуре $\text{TiN}/\text{Ge}_2\text{Sb}_2\text{Te}_5/\text{Au}$ 662

Пузанов А.С., Забавичев И.Ю., Абросимова Н.Д., Бибикова В.В., Волкова Е.В., Недошивина А.Д., Потехин А.А., Тарасова Е.А., Хазанова С.В., Логинов Б.А., Блинные Д.Ю., Второва В.С., Кириллова В.В., Ляшко Е.А., Макеев В.С., Первых А.Р., Оболенский С.В.

Флуктуационный анализ микрорельефа поверхности структур кремний-на-изоляторе после радиационного воздействия 668

● Микро- и нанокристаллические, пористые, композитные полупроводники

Иешкин А.Е., Татаринцев А.А., Сенатулин Б.Р., Скрылева Е.А.

Эволюция состава и рельефа поверхности полупроводников $\text{A}^{\text{III}}\text{B}^{\text{V}}$ в процессе распыления ионами аргона 676

● Углеродные системы

Глухова О.Е., Слепченков М.М., Петрунин А.А.

Электронная и дырочная подвижность в углеродных гибридных структурах 683

● Физика полупроводниковых приборов

Калинушкин В.П., Уваров О.В., Гладилин А.А., Миронов С.А., Поплавский М.В., Пупырев П.Д., Гаврищук Е.М., Савин Д.В., Тимофеева Н.А.

Влияние процедуры легирования железом CVD-ZnSe с помощью высокотемпературной диффузии на состав и пространственное распределение примесно-дефектных центров 695

Подоскин А.А., Шушканов И.В., Ризаев А.Е., Николаев Д.Н., Слипенченко С.О., Пихтин Н.А.

Импульсный фотоактивируемый ключ на основе полупроводникового лазера и высоковольтного фотодиода $\text{AlGaAs}/\text{GaAs}$ 703

Самарцев И.В., Байдусь Н.В., Зубков С.Ю., Баясников Д.М., Жидяев К.С., Здоровейщев А.В., Бобров А.И., Сидоренко К.В., Нежданов А.В., Клементьев Д.С.

Метаморфный InGaAs-фотодиод на длине волны 1.55 мкм, выращенный на подложке GaAs 709